

# X切H:LiNbO<sub>3</sub>光波导的工艺仿真研究\*

黄韬<sup>1</sup> 金锋<sup>1,2</sup> 刘福民<sup>1</sup> 徐宇新<sup>1</sup>

(1 中国航天时代电子公司研究院,北京 100854)

(2 中科院长春光学精密机械与物理研究所,长春)

**摘要** 对于X切H:LiNbO<sub>3</sub>光波导,在532 nm和1310 nm波长下,用棱镜耦合器进行了工艺仿真研究。对于在150℃,180℃和200℃用苯甲酸质子交换的光波导,分别求得交换厚度与交换时间的关系曲线,在此基础上给出质子交换的扩散系数与交换温度的关系曲线。对于在180℃质子交换并在350℃退火的光波导,给出以交换时间(交换厚度)为参变量的表面折射率增量、有效厚度与退火时间的关系曲线。研究结果可供低损耗 $\alpha$ 相单模波导的设计和制备做参考。

**关键词** 铌酸锂;光波导;质子交换;退火

**中图分类号** TN25

**文献标识码** A

## 0 引言

H:LiNbO<sub>3</sub>光波导具有制备工艺简单、传播损耗低、单偏振工作等优点,因此广泛用来制备调制器、光开关、倍频器和激光器,对其质子交换和退火等制备工艺已有深入的研究<sup>[1]</sup>。

H:LiNbO<sub>3</sub>光波导的工艺仿真,就是要在实验上求得光波导结构参数(折射率增量、有效厚度)与制备工艺参数(质子交换温度、时间及退火温度、时间)的关系曲线。N. Goto 和 G. L. Yip 等人,对于用焦磷酸质子交换的z切LiNbO<sub>3</sub>退火光波导,在633 nm光波长做了工艺仿真研究<sup>[2,3]</sup>。但是,其工艺仿真曲线中的表面折射率增量远大于 $\alpha$ 相的最大折射率增量0.03<sup>[4]</sup>,故这样的仿真曲线不能用于低损耗 $\alpha$ 相单模波导的设计和制备。对于x切LiNbO<sub>3</sub>退火质子交换光波导,目前尚未见到能用于低损耗 $\alpha$ 相单模波导设计的工艺仿真研究报导。

本文对x切H:LiNbO<sub>3</sub>光波导,分别在532 nm和1310 nm光波长,用Meticon2010型棱镜耦合器进行了比较系统的工艺仿真研究,给出光波导结构参数与制备工艺参数的关系曲线。退火波导工艺仿真曲线中的表面折射率增量在0.03左右,因此研究结果可用于低损耗 $\alpha$ 相单模波导的制备和设计。

## 1 质子交换工艺仿真

将x切LiNbO<sub>3</sub>晶片分别放入150℃、180℃和200℃苯甲酸中进行质子交换,制备出对应这三种温度的若干质子交换光波导样品。质子交换光波导具有近似阶跃性折射率分布,可视做平板波导<sup>[2]</sup>。对这些质子交换光波导样品的结构参数,即折射率增

量 $\Delta n_e$ 和交换厚度 $d_e$ ,在532 nm光波长用棱镜耦合器进行测量,结果列入表1。其中,折射率均指非寻常光折射率, $T_e$ 和 $t_e$ 分别为质子交换的摄氏温度和时间。

表1 质子交换光波导结构参数的测量数据

(a) $T_e = 150^\circ\text{C}$					
$t_e/\text{h}$	1.5	2	2.5	5.5	6
$d_e/\mu\text{m}$	0.283	0.323	0.357	0.548	0.570
$\Delta n_e(532\text{nm})$				0.141	0.141
(b) $T_e = 180^\circ\text{C}$					
$t_e/\text{h}$	5/6	2	3	4	
$d_e/\mu\text{m}$	0.309	0.568	0.709	0.950	
$\Delta n_e(532\text{nm})$		0.138	0.139	0.137	
(c) $T_e = 200^\circ\text{C}$					
$t_e/\text{h}$	0.5	1	2	3	4
$d_e/\mu\text{m}$	0.315	0.663	0.938	1.301	1.436
$\Delta n_e(532\text{nm})$		0.138	0.140	0.139	0.139

根据简单扩散理论, $d_e$ 与 $t_e$ 的关系式为

$$d_e = 2 \sqrt{D_e t_e} \quad (1)$$

式中,扩散系数可写成

$$D_e = D_0 \exp [-E/(KT)] \quad (2)$$

$D_0$ 为扩散常数, $E$ 为激活能, $K$ 为玻尔兹曼常数, $T=273+T_e$ 为质子交换的绝对温度。由于从LiNbO<sub>3</sub>晶片及其夹具放入苯甲酸开始到实现热平衡需要一定的预热时间 $t_0$ ,故式(1)应改写成

$$d_e = 2 \sqrt{D_e} (\sqrt{t_e} - \sqrt{t_0}) \quad (3)$$

图1是以 $T_e$ 为参变量的 $d_e \sim \sqrt{t_e}$ 关系曲线。其中,各种实心点表示测量数据,实线是拟合曲线。做为拟合常数的扩散系数,列入表2。与图1相对应的仿真公式为

$$d_e/\mu\text{m} = \begin{cases} 0.2384(\sqrt{t_e} - \sqrt{0.0033}), & T_e = 150^\circ\text{C} \\ 0.5678(\sqrt{t_e} - \sqrt{0.1585}), & T_e = 180^\circ\text{C} \\ 0.8677(\sqrt{t_e} - \sqrt{0.0889}), & T_e = 200^\circ\text{C} \end{cases} \quad (4)$$

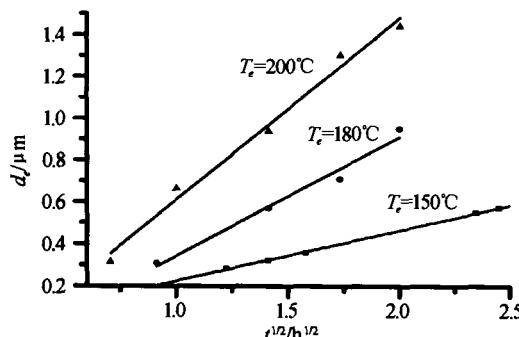
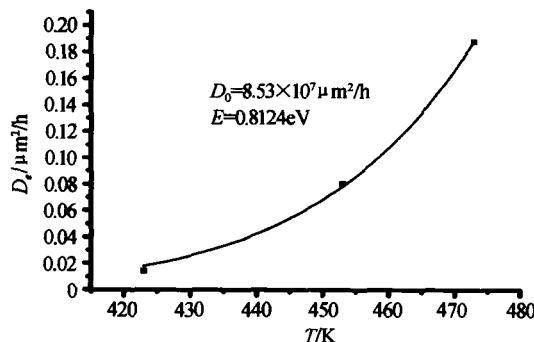
图 1  $d_e \sim t_e$  关系曲线Fig. 1 The relation curves of  $d_e \sim t_e$ .

表 2 质子交换扩散系数

$T_e/^\circ\text{C}$	150	180	200
$D_e/(\mu\text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1})$	0.0142	0.0806	0.1882

图 2 是  $D_e \sim T$  的关系曲线。其中, 实心点表示测量数据, 实线是式(2)的拟合曲线, 做为拟合常数的扩散常数为  $D_0 = 8.53 \times 10^7 \mu\text{m}^2/\text{h}$ , 而激活能为  $E = 0.8124 \text{ eV}$ , 与图 2 相对应的仿真公式为

$$D_e/(\mu\text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1}) = 8.53 \times 10^7 \exp[-9.426 \times 10^3 / T] \quad (5)$$
图 2  $D_e \sim T$  关系曲线Fig. 2 The relation curve of  $D_e \sim T$ 

由表 1 可知,  $\Delta n_e$  随  $t_e$  ( $d_e$ ) 变化基本保持常数, 并且在  $T_e = 150 \sim 200^\circ\text{C}$  范围内,  $\Delta n_e$  基本上与  $T_e$  无关, 有  $\Delta n_e(532 \text{ nm}) \approx 0.14$ . 为了提高  $d_e$  的控制精度,  $t_e$  应较长一些. 所需的  $d_e$ , 可用图 1 和图 2 及仿真公式(4)和(5), 调整  $T_e$  和  $t_e$  而求得. 并且  $d_e$  直接关系到退火质子交换光波导结构参数随退火时间的变化趋势.

## 2 退火工艺仿真

退火质子交换铌酸锂光波导的折射率分布, 可由广义高斯函数来模拟<sup>[3]</sup>

$$n(y) = n_b + \Delta n_e \exp[-(\frac{y}{d})^\alpha] \quad (6)$$

式中, 表面折射率增量  $\Delta n_e = n_s - n_b$  和波导有效厚度  $d$ , 分别由如下两个公式来模拟<sup>[3]</sup>

$$\Delta n_e = \Delta n_e (1 - p t_a^q) \quad (7)$$

$$d = d_e (1 + b t_a^c) \quad (8)$$

$n_s$  和  $n_b$  分别为波导的表面和衬底的折射率,  $y$  为波

导深度方向的坐标,  $\alpha$  为决定折射率分布形状的幂指数,  $t_a$  为退火时间,  $\Delta n_e$  和  $d_e$  分别为退火前质子交换波导的折射率增量和交换厚度,  $b, c, p, q$  为待定常数. 在式(7)和(8)中, 消去  $t_a$ , 推得  $\Delta n_e$  与  $d$  的关系式

$$\Delta n_e = \Delta n_e \left[ 1 - p \left( \frac{d - d_e}{b d_e} \right)^{q/c} \right] \quad (9)$$

首先在交换温度  $T_e = 180^\circ\text{C}$ , 交换时间  $t_e$  分别为 50, 75 和 100 min, 制备出三个 x 切 LiNbO<sub>3</sub> 质子交换光波导样品. 然后在退火温度  $T_a = 350^\circ\text{C}$ , 对这三个光波导样品进行了间断的退火实验, 制备出退火质子交换波导, 退火时间为  $t_a = 0, 1, 2, 3, 5, 7 \text{ h}$ . 对这些退火波导样品, 在 532 nm 和 1310 nm 光波长, 用棱镜耦合器测量光波导结构参数  $\Delta n_e$ ,  $d$  和  $\alpha$ , 其结果列入表 3.

表 3 退火质子交换光波导结构参数的测量数据

(a) $t_e = 50 \text{ min}, d_e = 0.309 \mu\text{m}$						
$t_a/\text{h}$	0	2	3.5	5	7	
$\Delta n_e(532 \text{ nm})$	0.042	0.028	0.021	0.016		
$\Delta n_e(1310 \text{ nm})$	0.031	0.021	0.015	0.011		
$d/\mu\text{m}$	0.309	1.180	1.672	2.177	2.610	
$\alpha$	1.661	1.723	1.754	1.559		
(b) $t_e = 75 \text{ min}, d_e = 0.424 \mu\text{m}$						
$t_a/\text{h}$	0	1	2	3.5	5	7
$\Delta n_e(532 \text{ nm})$	0.106	0.063	0.040	0.031	0.023	
$\Delta n_e(1310 \text{ nm})$	0.086	0.044	0.028	0.022	0.016	
$d/\mu\text{m}$	0.424	0.710	1.130	1.670	2.140	2.760
$\alpha$	1.613	1.462	1.591	1.580	0.665	
(c) $t_e = 100 \text{ min}, d_e = 0.560 \mu\text{m}$						
$t_a/\text{h}$	0	1	2	3.5	5	7
$\Delta n_e(532 \text{ nm})$	0.134	0.139	0.108	0.064	0.046	0.034
$\Delta n_e(1310 \text{ nm})$	0.090	0.115	0.086	0.032	0.022	0.024
$d/\mu\text{m}$	0.560	0.700	0.820	1.460	1.960	2.640
$\alpha$	1.234	1.231	1.372	1.554	1.839	

利用表 3 的数据和式(6)~(8), 画出以  $t_e(d_e)$  为参变量的  $\Delta n_e \sim t_a$ ,  $d \sim t_a$  和  $\alpha \sim t_a$  关系曲线, 分别示于图 3~6. 其中, 各种实心点表示测量数据, 实线是拟合曲线, 拟合常数  $b, c, p, q$  列入表 4.

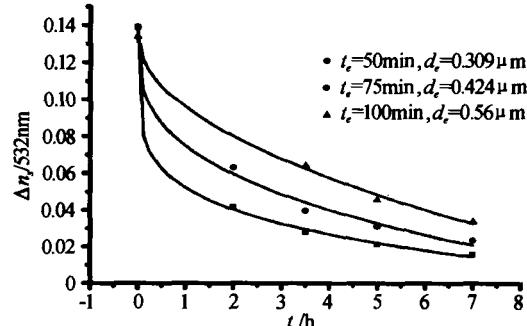
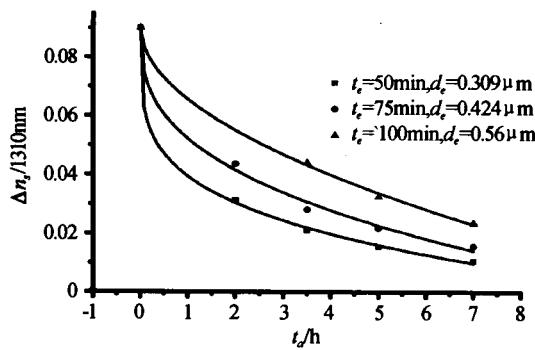
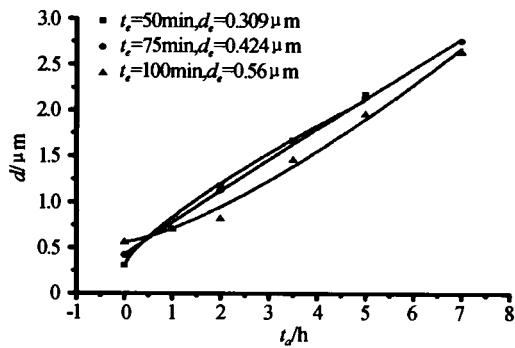
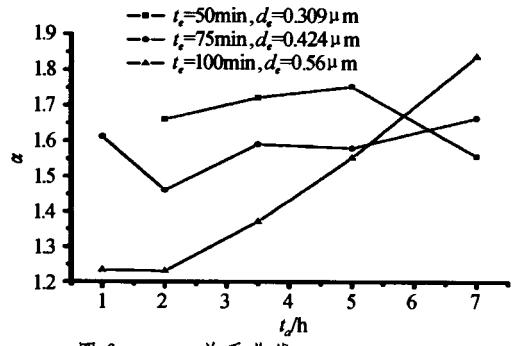


图 3  $\Delta n_e(532 \text{ nm}) \sim t_a$  关系曲线  
Fig. 3 The relation curves of  $\Delta n_e(532 \text{ nm}) \sim t_a$

图 4  $\Delta n_s(1310 \text{ nm}) \sim t_a$  关系曲线Fig. 4 The relation curves of  $\Delta n_s(1310 \text{ nm}) \sim t_a$ 图 5  $d \sim t_a$  关系曲线Fig. 5 The relation curves of  $d \sim t_a$ 图 6  $\alpha \sim t_a$  关系曲线Fig. 6 The relation curves of  $\alpha \sim t_a$ 表 4 拟合常数  $b, c, p, q$  ( $T_r = 180^\circ\text{C}$ ,  $T_a = 350^\circ\text{C}$ )(a)  $t_a = 50 \text{ min}, d_e = 0.309 \mu\text{m}$ 

$\lambda/\text{nm}$	$p$	$q$	$b$	$c$
532	0.625	0.185		
1310	0.563	0.235	1.706	0.764

(b)  $t_a = 75 \text{ min}, d_e = 0.424 \mu\text{m}$ 

$\lambda/\text{nm}$	$p$	$q$	$b$	$c$
532	0.459	0.318		
1310	0.422	0.356	0.842	0.971

(c)  $t_a = 100 \text{ min}, d_e = 0.560 \mu\text{m}$ 

$\lambda/\text{nm}$	$p$	$q$	$b$	$c$
532	0.283	0.506		
1310	0.273	0.515	0.265	1.360

与图 3、4 和 5 相对应的仿真公式分别为

$$\Delta n_s(532 \text{ nm}) = \begin{cases} 0.139(1 - 0.625t_a^{0.185}), & t_a = 50 \text{ min} \\ 0.139(1 - 0.459t_a^{0.318}), & t_a = 75 \text{ min} \\ 0.134(1 - 0.283t_a^{0.506}), & t_a = 100 \text{ min} \end{cases} \quad (10)$$

$$\Delta n_s(1310 \text{ nm}) = \begin{cases} 0.09(1 - 0.563t_a^{0.235}), & t_a = 50 \text{ min} \\ 0.09(1 - 0.422t_a^{0.356}), & t_a = 75 \text{ min} \\ 0.09(1 - 0.273t_a^{0.515}), & t_a = 100 \text{ min} \end{cases} \quad (11)$$

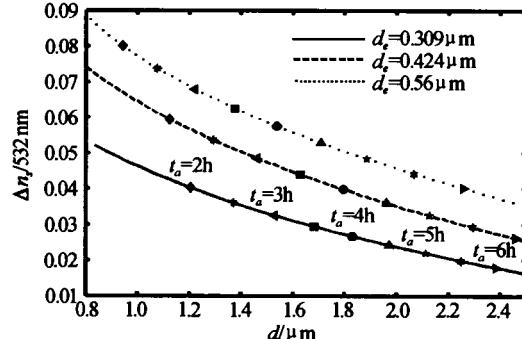
$$d/\mu\text{m} = \begin{cases} 0.309(1 + 1.706t_a^{0.764}), & t_a = 50 \text{ min} \\ 0.424(1 + 0.842t_a^{0.971}), & t_a = 75 \text{ min} \\ 0.56(1 + 0.265t_a^{1.36}), & t_a = 100 \text{ min} \end{cases} \quad (12)$$

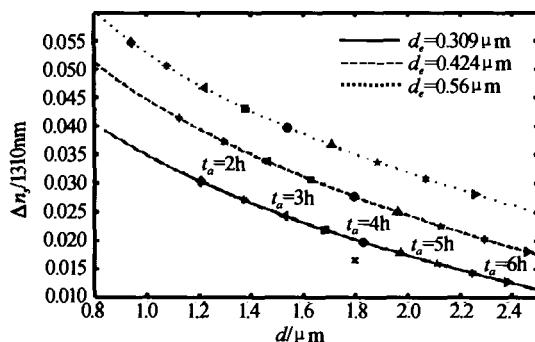
将表 4 中的  $b, c, p, q$  的数据代入式(9), 得到  $\Delta n_s$  与  $d$  关系的仿真公式

$$\Delta n_s(532 \text{ nm}) = \begin{cases} 0.139 \left[ 1 - 0.625 \left( \frac{d - 0.309}{0.527} \right)^{0.242} \right], & d_e = 0.309 \mu\text{m} \\ 0.139 \left[ 1 - 0.459 \left( \frac{d - 0.424}{0.357} \right)^{0.327} \right], & d_e = 0.424 \mu\text{m} \\ 0.134 \left[ 1 - 0.283 \left( \frac{d - 0.56}{0.148} \right)^{0.372} \right], & d_e = 0.56 \mu\text{m} \end{cases} \quad (13)$$

$$\Delta n_s(1310 \text{ nm}) = \begin{cases} 0.09 \left[ 1 - 0.563 \left( \frac{d - 0.309}{0.527} \right)^{0.308} \right], & d_e = 0.309 \mu\text{m} \\ 0.09 \left[ 1 - 0.422 \left( \frac{d - 0.424}{0.357} \right)^{0.367} \right], & d_e = 0.424 \mu\text{m} \\ 0.09 \left[ 1 - 0.273 \left( \frac{d - 0.56}{0.148} \right)^{0.379} \right], & d_e = 0.56 \mu\text{m} \end{cases} \quad (14)$$

利用式(13)和(14), 画出以  $d_e$  和  $t_a$  为参变量的  $\Delta n_s$  ~  $d$  关系曲线分别示于图 7 和图 8, 其中各种实心点

图 7  $\Delta n_s \sim d$  关系曲线 ( $\lambda = 532 \text{ nm}$ )Fig. 7 The relation curves of  $\Delta n_s(532 \text{ nm}) \sim d$

图 8  $\Delta n_r \sim d$  关系曲线 ( $\lambda=1310$  nm)Fig. 8 The relation curves of  $\Delta n_r$  (1310 nm)  $\sim d$ 

表示  $t_a$ . 退火质子交换光波导的工艺仿真可归结于这两个图, 使用起来比较方便.

由图 3、4 和 5 可以看出, 就退火质子交换波导而言,  $\Delta n_r$  随  $t_a$  的增加而单调递减, 且  $d$  随  $t_a$  的增加而单调递增. 对于确定的  $t_a$ ,  $\Delta n_r$  随  $t_e(d_e)$  的增加而增加; 且对于确定的  $t_a > 1h$ ,  $d$  随  $t_e(d_e)$  的增加而递减. 由图 6 可见,  $\alpha$  随  $t_a$  的变化, 先递减而后递增, 根据有限源扩散理论, 最终趋于 2; 而在有用的  $t_a = 4 \sim 7h$  范围内,  $\alpha = 1.4 \sim 1.8$ . 对于确定的  $t_a < 5h$ ,  $\alpha$  随  $t_e(d_e)$  的增加而递减. 光波导结构参数  $\Delta n_r$ 、 $d$  和  $\alpha$  随  $t_a$  的变化趋势, 与  $t_e(d_e)$  紧密相关. 由图 7 和图 8 可以看到,  $\Delta n_r$  随  $d$  的增加而单调递减, 而对于确定的  $d$ ,  $\Delta n_r$  随  $t_e(d_e)$  的增加而增加.

对于确定的  $T_e = 180^\circ\text{C}$  和  $T_a = 350^\circ\text{C}$ , 用图 3 至图 8 以及仿真公式(10)至(14), 调整  $t_e$  和  $t_a$ , 可以求得合适的退火质子交换波导结构参数  $\Delta n_r$ 、 $d$  和  $\alpha$ , 设计出低损耗  $\alpha$  相单模光波导.

### 3 单模条形波导工艺仿真

就退火质子交换条形光波导而言, 带尾纤的光波导插入损耗可分解为光纤-光波导耦合损耗、光波导传播损耗和界面反射损耗. 低的耦合损耗要求光纤和光波导的光斑匹配, 即它们的重叠积分要大一些. 低的传播损耗则要求光波导层处于  $\alpha$  相.

为了实现低的插入损耗, 首先根据式(6)用束传播方法对耦合损耗(重叠积分)进行模拟运算, 寻找低耦合损耗的单模光波导结构参数  $\Delta n_r$ 、 $d$  和  $\alpha$  的取值范围(具体计算过程在另文中阐述). 再用仿真公式(10)~(14)以及图 3~图 8, 寻找对应于低损耗光波导结构参数的工艺参数  $t_e$  和  $t_a$  的取值范围. 同时要考虑到这些工艺参数使光波导层处于  $\alpha$  相, 以便降低传播损耗.

根据上述优化设计方法, 对于  $T_e = 180^\circ\text{C}$  和  $T_a = 350^\circ\text{C}$ , 选用  $t_e = 50$  min 和  $t_a = 4h$ , 制备出 1310 nm X 切退火质子交换光波导, 其条宽为 6  $\mu\text{m}$ . 这一工艺仿真点和相应的测量点分别用  $d_e = 0.309 \mu\text{m}$  和  $t_a = 4h$  的圆点和“x”点示于图 8. 仿真点和测量点比较接近, 其差别可能由断续退火代替连续退火所致. 这一退火质子交换光波导的插入损耗测量值为 2.4 dB, 可分解为 2 dB 耦合损耗、0.2 dB 反射损耗和 0.2 dB 传播损耗. 一个界面的耦合损耗 1 dB, 与束传播方法的模拟计算值相符. 这一光波导近场的红外摄相照片示于图 9, 其光斑尺寸接近 1.3  $\mu\text{m}$  单模光纤光斑尺寸  $\sim 9 \mu\text{m}$ .



图 9 退火质子交换条形光波导近场照片

Fig. 9 The near field photograph of annealing-exchange strip wave guide

综上所述, 本文对 X 切 H : LiNbO<sub>3</sub> 光波导进行了系统的工艺仿真研究, 研究结果可供低损耗  $\alpha$  相单模波导的制备和设计参考.

最后感谢杜天敏、司磊、徐建营、张玉丹、王红飞和张海廷在条形波导的制备和测量过程中给予的帮助.

### 参考文献

- 1 张德龙, 丁桂兰, 崔宇明, 等. 质子交换 LiNbO<sub>3</sub> 光波导. 物理学进展, 2001, 21(1): 45~65  
Zhang D L, Ding G L, Cui Y M, et al. Progress in Physics, 2001, 21(1): 45~65
- 2 Goto N, Yip G L. Characterization of proton-exchange and annealed LiNbO<sub>3</sub> waveguides with pyrophosphoric acid. *Applied Optics*, 1989, 28(1): 60~65
- 3 Kolopoulos J N, Yip G L. Accurate modeling of the index profile in annealed proton-exchanged LiNbO<sub>3</sub> waveguides. *SPIE*, 1991, 1583: 71~82
- 4 Korkishko Y N, Fedorov V A, Demicheli M P, et al. Relationship between structural and optical properties of proton-exchanged waveguide on z-cut Lithium niobate. *Appl Opt*, 1996, 35(36): 7056~7060

## Technical Modeling of X-cut H : LiNbO<sub>3</sub> Optical Waveguides

Huang Tao<sup>1</sup>, Jin Feng<sup>1,2</sup>, Liu Fumin<sup>1</sup>, Xu Yuxin<sup>1</sup>

1 China Academy of Aerospace Times Electronics Corporation, Beijing 100854

2 Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy, Changchun

Received date: 2004-05-31

**Abstract** Technical modeling of x-cut H : LiNbO<sub>3</sub> optical waveguides is researched by prism coupler at the wavelength of 532 nm and 1310 nm. For optical waveguides proton-exchanged in pure benzoic acid at 150°C, 180°C and 200°C, relationships between exchanged thickness and exchanged time are given, respectively, and on this base, a relation curve of diffussion coefficient of proton-exchange to exchanged temperature is plotted. For the waveguides proton-exchanged at 180°C and annealed at 350°C, the changes of surface refractive index increment and effective thichness with annealing time are obtained. The results can be used to design and fabricate the low loss  $\alpha$  phase single mode waveguides.

**Keywords** LiNbO<sub>3</sub>; Optical waveguide; Proton-exchange; Annealing

**Huang Tao** was born in September 1978, in Fujian Province, China. In 2001, He received the B. S. degree from Department of Applied Physics, Nanjing University of Science & Technology. He is doing a research on integrated optical modulator as a R&D Engineer in Lab of Integrated Optics of China Academy of Aerospace Times Electronics Corporation.

